

采用WLCSP封装的小信号MOSFET

最小尺寸 – 最低导通电阻 $R_{DS(on)}$



采用WLCSP封装的小信号MOSFET提供同类最佳导通电阻 $R_{DS(on)}$ 空间比, 与DFN1010封装相比, 节省了高达45%的空间。它是性能高于等效器件(采用DFN封装)的小尺寸应用的理想解决方案。此封装产品包括N沟道MOSFET和P沟道MOSFET, 所有元件集成额定值 $>2kV$ 的ESD保护元件, 并且额定功率 $>1300mW$ 。

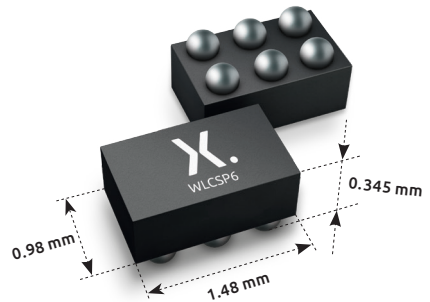
特性

- › 低导通电阻 $R_{DS(on)}$, 最低 $15 m\Omega$
- › 同类产品最佳导通电阻 $R_{DS(on)}$ 空间比
- › 每 mm^2 最低导通电阻 $R_{DS(on)}$
- › 便于PCB设计
- › ESD保护 $> 2 kV$
- › I_o 最高达到 $9.6 A$
- › 低压驱动 ($V_{GS(th)} = 0.6 V$ 典型值)
- › $V_{DS} = 12-20 V$; $V_{GS} = 8 V$
- › 产品包括P沟道MOSFET, N沟道MOSFET



典型应用

- › 可穿戴设备
- › 电子烟
- › 移动配件
- › 助听器
- › 身份证
- › 计算配件
- › 电池极性
- › 用于便携式设备的负载开关
- › 电池开关
- › LED驱动器

小尺寸



产品范围

极性	V_{DS} (V)	V_{GS} (V)	I_D (A)	V_{GSth} 最小值 (V)	V_{GSth} 最大值 (V)	ESD保护 (kV)	R_{DSon} 典型值 (m Ω) @ $V_{GS} =$				WLCSP4	WLCSP6
							4.5 V	2.5 V	1.8 V	1.5 V		
N	12	8	6	0.4	0.9	2	36	46	60	86	PMCM4401VNE	
			9.6	0.4	0.9	2	15	18	22	30		PMCM6501VNE
	20	8	5.5	0.4	0.9	2	43	55	65	75	PMCM4401UNE	
			8.7	0.4	0.9	2	17	20	22	30		PMCM6501UNE
P	12	8	4.9	0.4	0.9	2	55	77	110	-	PMCM4401VPE	
			8.2	0.4	0.9	2	19	25	37	-		PMCM6501VPE
	20	8	4	0.4	0.9	2	75	95	130	-	PMCM4401UPE	
			4.2	0.4	0.9	2	65	88	120	-	PMCM4402UPE	
			7.3	0.4	0.9	2	22	28	38	-		PMCM6501UPE

© 2018 Nexperia B.V.

保留所有权利。未经版权所有者优先书面同意，禁止复制本文全部或部分內容。本文档中所提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，且被认为是准确可靠的，如有变更，恕不另行通知。对于使用本文档所产生的任何后果，出版方概不承担任何责任。出版內容既不传达也不暗示专利或者其他工业或知识产权下的任何许可。

发布日期:

2018年3月